# 動的再結晶過程の Phase-Field シミュレーション Phase-Field Simulation of Dynamic Recrystallization Process

学 久國陽介 (神戸大・院) 正 高木知弘 (神戸大・院)

正 冨田佳宏 (神戸大・院)

Yousuke HISAKUNI, Graduate School of Engineering, Kobe University, 1-1, Rokko-dai, Nada, Kobe, Hyogo

Tomohiro TAKAKI, Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University, 5-1-1, Fukaeminami, Higashinada, Kobe, Hyogo

Yoshihiro TOMITA, Graduate School of Engineering, Kobe University, 1-1, Rokko-dai, Nada, Kobe, Hyogo

Key Words: Phase Field Method, Dynamic Recrystallization, Microstructure Evolution, Dislocation

#### 1. 緒言

熱間加工過程では,高温のために変形と同時に回復 や再結晶が生じる動的復旧過程が進行する.このとき, 材料が持つ積層欠陥エネルギー(SFE)の大きさによっ て,動的復旧過程として動的回復あるいは動的再結晶 が支配的になることが知られている.すなわち,中~ 低SFE材においては,転位の拡張傾向が強まり,回復 に伴う転位の再配列において,転位の上昇運動が起こ りにくくなるために動的回復が困難になり,その結果, 蓄積された転位が駆動力となって動的再結晶が生じる. このように動的再結晶は複雑な現象であり,その詳細 なメカニズム解明のために実験<sup>(1)</sup>および数値的<sup>(2)</sup>な面 からの研究が進められている.

本研究では,再結晶核生成および再結晶粒成長を Phase-Field 法を用いてモデル化し,動的再結晶過程に おける特徴的な力学特性と微視組織の発展を評価する ことを目的とする.特に本稿では,力学的応答の初期 粒径依存性について基本的な特性を検討する.

#### 2. Phase-Field モデリング

文献[3]で構築したMulti-Phase-Fieldモデルを用いて, 再結晶粒成長を表現する.ここで, phase field *φ* の時 間発展方程式は次式のように与えられる.

$$\dot{\phi}_{i} = -\sum_{j=1}^{n} \frac{M_{ij}^{\phi}}{n} \left[ \sum_{k=1}^{n} \left\{ \left( W_{ik} - W_{jk} \right) \phi_{k} + \frac{1}{2} \left( a_{ik}^{2} - a_{jk}^{2} \right) \nabla^{2} \phi_{k} \right\} \right]$$
(1)

ここで,  $\Delta E_{ij}, M^{\phi}_{ij}, W_{ij}, a_{ij}$ はそれぞれ駆動力,モビリティー,エネルギー障壁の高さ,勾配係数であり,それ ぞれ次のように関連付けられる.

$$\Delta E_{ij} = \tau \left( \rho_j - \rho_i \right), M_{ij}^{\phi} = \frac{\pi^2}{4\delta} M_{ij},$$

$$W_{ij} = \frac{4\gamma_{ij}}{\delta}, a_{ij} = \frac{2}{\pi} \sqrt{2\delta\gamma_{ij}}$$
(2)

ここで,
$$\tau$$
,  $\delta$ ,  $M_{ij}$ ,  $\gamma_{ij}$ はそれぞれ転位線エネルギー, 界面幅, 粒界モビリティー, 粒界エネルギーである. 界面幅は差分格子間距離 $Ax$ の7倍,  $\delta = 7Ax$ としている.

再結晶粒の核生成は,バルジング機構により引き起こされるとし,高角粒界上の転位密度が式(3)で表される臨界値に達した場合に核を生成させる<sup>(2)</sup>.



Fig.1 Numerical Procedure. Table.1 Input parameters.

$$\rho_c = \left(\frac{20\gamma\dot{\varepsilon}}{3\tilde{b}\,LM\,\tau^2}\right)^{1/3} \tag{3}$$

ここで, $\dot{arepsilon}$ , $\widetilde{b}$ ,Lはそれぞれ,ひずみ速度,バーガー スベクトルの大きさ,転位の平均自由行程である.

核生成速度は,温度とひずみ速度の関数と仮定し, 次式を用いる.

$$\dot{n} = c\dot{\varepsilon}^m \exp\left(-\frac{Q_{act}}{RT}\right) \tag{4}$$

ここで, *c*, *Q*<sub>act</sub> は定数,活性化エネルギーである.

転位の蓄積に関しては Kocks, Mecking が提唱した次 式の KM モデルを用いる.

$$\frac{d\rho}{d\varepsilon} = k_1 \sqrt{\rho} - k_2 \rho \tag{5}$$

ここで, k<sub>1</sub>は定数, k<sub>2</sub>は温度とひずみ速度の関数であ り, いずれも実験値より定められる.

解析手順を図 1 に示す.式(4)のKMモデルに従って 転位密度を発展させ,転位密度が核生成条件である臨 界転位密度ρ<sub>c</sub>に達した格子点上に核を配置する.その 後,Phase-Field法によって粒成長させ,この手順を所 定のひずみ値まで繰返し行う.

#### 3. シミュレーションモデル

初期粒径の影響を検討するため,初期平均粒径D<sub>0</sub>が 24,30,57 µmとなるよう初期組織を作成する.解析領域 は200×200µm (400×400 lattices)とし,x,y方向端面を 周期境界としている.OFHC銅を対象とし,各物性値を 表1に示す.温度を775 K,ひずみ速度を2.0×10<sup>-3</sup> 1/s として,ひずみ0.5 まで解析を行った.なお核生成は, 粒界上に円形の再結晶粒を配置するが,動的再結晶の 駆動力は非常に小さいため,臨界半径が非常に大きく なる.そこで, $\Delta E_{ij}=4\Delta E_{ij}$ とすることで核サイズを小さくし, $M^{\phi}_{ij}=1/4 M^{\phi}_{ij}$ により粒成長速度を調整している.

## 4. シミュレーション結果と考察

解析の結果得られた真応力-真ひずみ曲線を図2に示 す.真応力は次式により解析領域全体の平均転位密度 から算出する.

(6)

 $\sigma = \alpha \mu \tilde{b} \sqrt{\rho}$ 

いずれの初期粒径においても, ひずみが 0.12 に達した あたりで応力が最大となった後,再結晶粒の成長が顕 著になることで平均転位密度が減少し, ひずみ 0.16 か ら 0.18 あたりまで応力の減少が続く. ほぼ全領域が再 結晶粒で満たされると,変形による転位の蓄積が支配 的になり,再び応力が増加していく.その後D<sub>0</sub> = 24,30 μmの場合では、ひずみ 0.25 あたりで応力の増加がとま リ,再び再結晶粒成長が顕著になることで応力が減少 している.動的再結晶過程は,変形による応力の増加 と再結晶粒成長による減少のサイクルを繰り返して進 行していく.応力の増加と減少は変形が進むにつれて 減衰していくが,初期粒径によって減衰の度合いが異 なり,初期粒径が大きいほど,早い段階で応力がほぼ 一定に落ち着く傾向が確認できる.また,初期粒径が 大きいほど応力の極大,極小値の差が小さいこともみ てとれる.

続いて,より詳細な検討をするために各粒径による 再結晶分率の発展を比較する.図3は各粒径における, 再結晶分率の変化を示している.再結晶分率は再結晶 粒が占める格子点数を全体の格子点数で割ることで求 めている.初期粒径が大きいほど,再結晶がゆっくり 進行していくことがわかる.したがって,初期粒径が 大きいほど,再結晶が完了する前に新たな再結晶が進 行する可能性が高まる傾向が確認できる.このような 場合,変形による転位密度の増加と再結晶粒成長によ る減少とが同程度に進むために,応力-ひずみ曲線にお ける応力の増減が穏やかになる.この傾向は図2にお いても確認できた.

併せて,ひずみ 0.12 から 0.18 における微視組織を図 4 に示す. $D_0 = 57$  μmの場合,ひずみ 0.18 においても 初期結晶粒が残っているが, $D_0 = 24$  μmでは,ひずみ 0.16 においてほぼ全体にわたって再結晶が完了してい る.再結晶核は主にバルジング機構により粒界より成 長していく.初期粒径が小さい場合では,解析領域を 粒界が細かくわたることから,再結晶粒が広く分布し, 比較的早い段階で再結晶を完了する傾向がうかがえる.

### 5. 参考文献

- [1] T. Sakai and J. J. Jonas, Acta Metall., 32 (1984), 189-209
- [2] R. Ding and Z. X. Guo, Acta mater. 49 (2001), 3163-3175
- [3] T. Takaki, A. Yamanaka and Y. Tomita, Proc. ATEMA (2007), (in press).



Fig.2 Stress strain curves. Fig.3 Recrystallized volumefraction.



Fig.4 Evolution of microstructures. (a)  $\varepsilon = 0.12$ , (b) 0.14, (c) 0.16, and (d) 0.18.